

УДК 548.24

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ  
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО  
СОСТОЯНИЯ В ПЯТНЕ ЛОКАЛЬНОГО  
ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ****О.М. ОСТРИКОВ, С.А. НАГЕЛЬ***Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П.О. Сухого»,  
Республика Беларусь*

Главным недостатком методов лазерной и электроэрозионной обработок являются избыточные термические напряжения, которые создаются в обрабатываемом материале [1]. При высоком уровне этих напряжений возможно неблагоприятное, с практической точки зрения, зарождение микротрещин. Поэтому изучение напряженного состояния в областях локального термического воздействия имеет важное практическое значение.

Целью данной работы явилось моделирование на основании принципа электростатических аналогий напряженного состояния в областях лазерного или электроэрозионного воздействий.

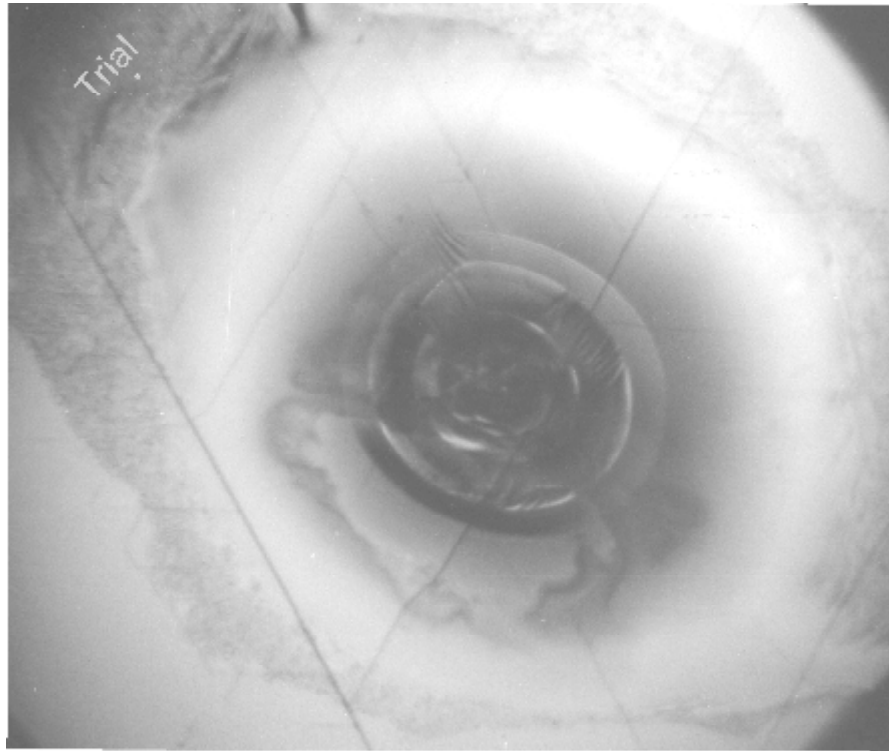
На рис. 1 представлены фотоснимки морфологии поверхности (111) монокристаллического кремния в области лазерного (рис. 1, а) и электроэрозионного (рис. 1, б) воздействий. У пятна лазерного воздействия (при плотности излучения порядка  $10^5$  Дж/м<sup>2</sup>) часто возникает сетка следов пирамидального скольжения (рис. 1, а), которая в случае электроэрозионной обработки при плотности тока 100 А/мм<sup>2</sup>, как правило, отсутствует (рис. 1, б). При активном развитии пирамидального скольжения при избыточной плотности дислокаций, движущихся вдоль направления сдвига, возможно зарождение трещин по дислокационному механизму [2].

Представим область локального термического воздействия в виде шарового сегмента, усеченного плоскостью  $XOY$ , совпадающей с поверхностью кристалла. Вид этого пятна в плоскости  $XOZ$  представлен на рис. 2, а. Пусть след этого пятна в плоскости  $XOY$  будет иметь вид окружности радиусом  $L$  (рис. 2, б). Для учета поверхностных эффектов необходим расчет сил изображения, которые находятся путем определения вклада такого же, как на рис. 2, сегмента, но зеркально симметрично расположенного по отношению к поверхности, то есть к плоскости  $XOY$ . Форма такой области, состоящей из двух зеркально симметричных элементов, может быть получена пересечением двух шаров (рис. 3) радиусом  $R$ , задаваемых уравнениями

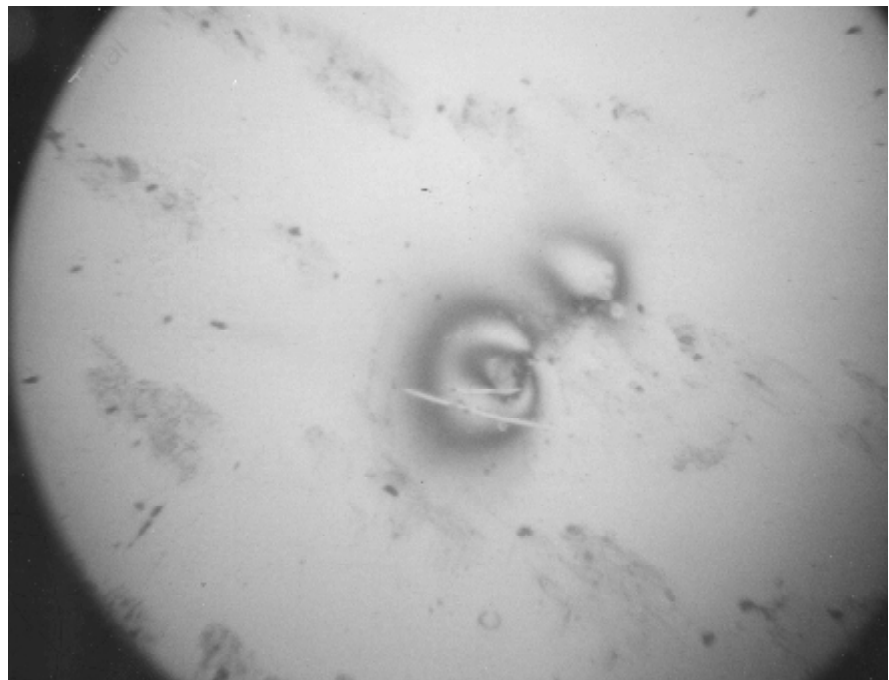
$$x^2 + y^2 + (z + R - H)^2 = R^2; \quad (1)$$

$$x^2 + y^2 + (z + H - R)^2 = R^2, \quad (2)$$

где  $H$  – глубина термического воздействия.

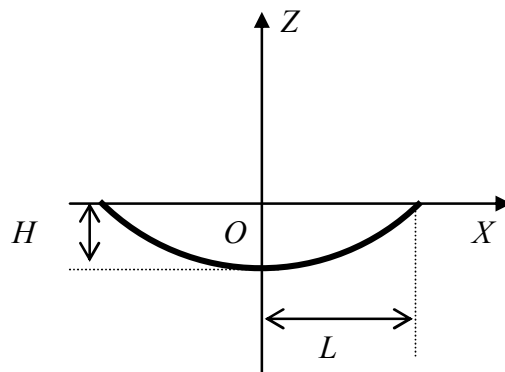


a)

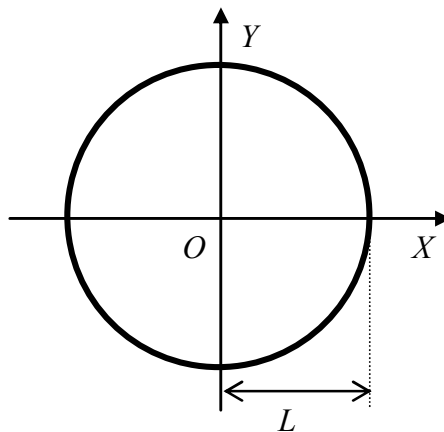


b)

*Рис. 1*



a)



б)

Рис. 2. Схематическое изображение области локального термического воздействия:  
 а – в плоскости  $XOZ$ ; б – в плоскости  $XOY$ . Плоскость  $XOY$  совпадает с поверхностью кристалла

Очевидно, что проекция области пересечения рассматриваемых шаров на плоскость  $XOY$  ( $z = 0$ ) может быть описана уравнением

$$x^2 + y^2 = L^2. \quad (3)$$

Из (3) и (1) или (2) следует необходимая для будущих расчетов связь  $R$  с  $H$  и  $L$ :

$$R = \frac{L^2 + H^2}{2H}, \quad (4)$$

при этом в (1) и (2) полагалось  $z = 0$ .

В общем виде потенциал  $\varphi(\vec{r})$  электростатического поля, создаваемого зарядом, распределенным с плотностью  $\sigma(\vec{r}')$  по поверхности  $S'$ , – границы области локального термического воздействия и симметричной ей относительно плоскости  $XOY$  области (рис. 4), может быть представлен в виде [3], [4]

$$\varphi(\vec{r}) = k \iint_{S'} \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS', \quad (5)$$

где  $k$  – постоянная;  $\vec{r}$  и  $(\vec{r} - \vec{r}')$  – радиус-векторы, определяемые по схеме, представленной на рис. 4.

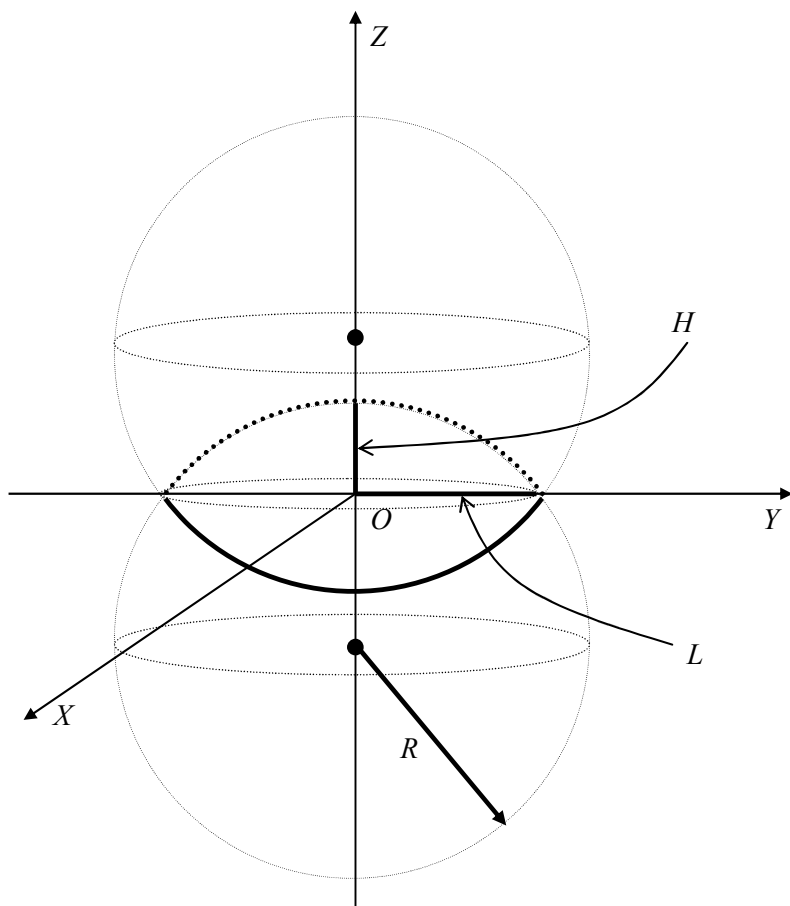


Рис. 3. Схема получения области локального термического воздействия и области изображения пересечением двух шаров

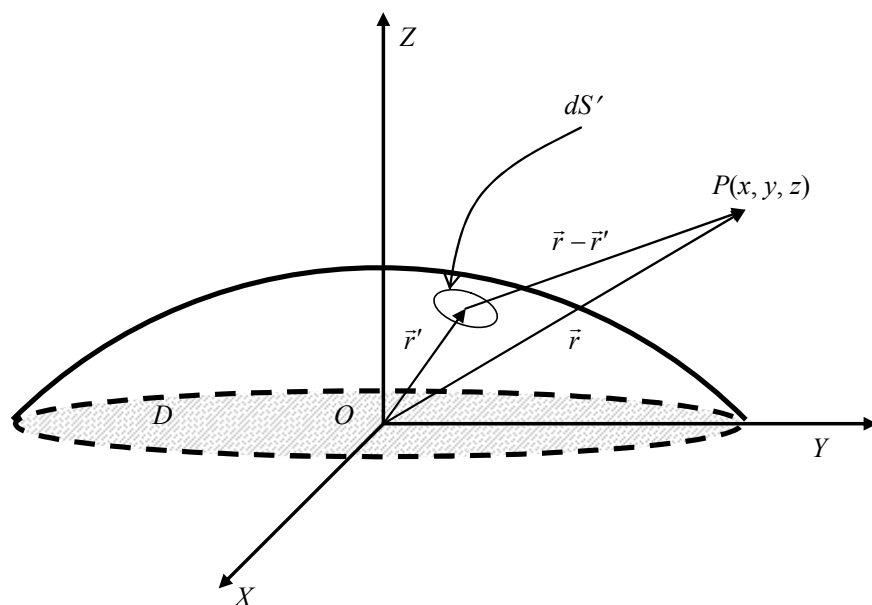


Рис. 4. Схема для расчета потенциала электрического поля для одной из поверхностей области локального термического воздействия

Ввиду симметричности решаемой задачи относительно плоскости  $XOY$ , рассмотрим вначале потенциал изображения, создаваемый заряженной поверхностью, находящейся в

положительной по отношению к оси  $z$  области пространства (см. рис. 4). Данный потенциал имеет вид:

$$\begin{aligned}\varphi_1(x, y, z) &= k \iint_D \frac{\sigma(x', y', z') \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z'}{\partial x'}\right)^2 + \left(\frac{\partial z'}{\partial y'}\right)^2} dx' dy'}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} = \\ &= k \iint_D \frac{\sigma(x', y', z') \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z'}{\partial x'}\right)^2 + \left(\frac{\partial z'}{\partial y'}\right)^2} dx' dy'}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + \left(z - (H-R) - \sqrt{R^2 - x'^2 - y'^2}\right)^2}},\end{aligned}\quad (6)$$

где осуществлен переход от интегрирования в (5) по области  $S'$  к интегрированию в области  $D$  [5], описываемой уравнением (3). Учитывая (1), не трудно показать, что в (6)

$$\left(\frac{\partial z'}{\partial x'}\right)^2 = \frac{4x'^2}{R^2 - x'^2 - y'^2}; \quad (7)$$

$$\left(\frac{\partial z'}{\partial y'}\right)^2 = \frac{4y'^2}{R^2 - x'^2 - y'^2}. \quad (8)$$

Тогда (6) примет вид

$$\varphi_1(x, y, z) = k \iint_D \frac{\sigma(x', y', z') \sqrt{1 + \frac{4(x'^2 + y'^2)}{R^2 - x'^2 - y'^2}} dx' dy'}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + \left(z - (H-R) - \sqrt{R^2 - x'^2 - y'^2}\right)^2}}. \quad (9)$$

В данной работе рассмотрим случай, когда

$$\sigma(x', y', z') = \text{const} = \sigma_0. \quad (10)$$

Это означает, что принимается допущение о том, что потенциал поля упругих напряжений в области локального термического воздействия будет иметь такой же вид, как и потенциал электростатического поля заряда, равномерно распределенного по поверхности  $S'$ .

Переходя к полярным координатам

$$x' = \rho \cos \varphi, \quad y' = \rho \sin \varphi, \quad dx' dy' = \rho d\rho d\varphi, \quad (11)$$

для области изображения получим

$$\varphi_1(x, y, z) = k\sigma_0 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^L \frac{\sqrt{1 + \frac{4\rho^2}{R^2 - \rho^2}} \rho d\rho}{\sqrt{(x - \rho \cos \varphi)^2 + (y - \rho \sin \varphi)^2 + \left(z - (H-R) - \sqrt{R^2 - \rho^2}\right)^2}}. \quad (12)$$

Аналогично, используя (2), для другой поверхности, являющейся границей области термического воздействия, получим

$$\varphi_2(x, y, z) = k\sigma_0 \int_0^{2\pi} \int_0^L d\varphi \int_0^R \frac{\sqrt{1 + \frac{4\rho^2}{R^2 - \rho^2}} \rho d\rho}{\sqrt{(x - \rho \cos \varphi)^2 + (y - \rho \sin \varphi)^2 + \left(z - (R - H) + \sqrt{R^2 - \rho^2}\right)^2}}. \quad (13)$$

Очевидно, что потенциал  $\varphi(x, y, z)$ , создаваемый зарядом на границе области термического воздействия с учетом потенциала изображения, находится из соотношения

$$\varphi(x, y, z < 0) = \varphi_2(x, y, z) - \varphi_1(x, y, z). \quad (14)$$

Переход к задачам теории упругости осуществляется сопоставлением электростатическому потенциалу  $\varphi$  упругого смещения  $\vec{u}$  [6]. При этом при отсутствии вихревых полей связь между  $\vec{u}$  и  $\varphi$  находится из соотношения

$$\vec{u} = \text{grad}\varphi. \quad (15)$$

Отсюда получим

$$\vec{u} = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} + u_z \vec{k}, \quad (16)$$

где

$$u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}; \quad u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}; \quad u_z = \frac{\partial \varphi}{\partial z}, \quad (17)$$

а  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  – ортонормированный базис, единичные векторы которого направлены вдоль осей декартовой системы координат.

Компоненты тензора деформации находятся из выражений

$$u_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right), \quad \text{при } i = j; \quad (18)$$

$$\gamma_{ij} = 2u_{ij}, \quad \text{при } i \neq j. \quad (19)$$

Не трудно показать, что из (17), (18) и (19) следует

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}; \quad u_{yy} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}; \quad u_{zz} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}; \quad (20)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}; \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial z}; \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial z}. \quad (21)$$

Данные выражения получены с использованием потенциала  $\varphi(x, y, z)$  без учета  $k$  (см. (12), (13)). Физические уравнения теории упругости, связывающие напряжения и деформации для линейно-упругих изотропных тел, к которым отнесем подвергнутый термическому воздействию материал, имеют вид [7]:

$$\begin{cases} \sigma_{xx} = 2\mu u_{xx} + \lambda(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \\ \sigma_{yy} = 2\mu u_{yy} + \lambda(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \\ \sigma_{zz} = 2\mu u_{zz} + \lambda(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}), \\ \tau_{xy} = \mu \gamma_{xy}; \quad \tau_{xz} = \mu \gamma_{xz}; \quad \tau_{yz} = \mu \gamma_{yz}, \end{cases} \quad (22)$$

где  $\mu$  – модуль сдвига;  $\lambda = 2\mu\nu/(1-2\nu)$  – параметр Ляме (здесь  $\nu$  – коэффициент Пуассона).

Результаты компьютерных расчетов представлены на рис. 5. Установлено, что нормальные компоненты тензора напряжений равны друг другу, т. е.  $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz}$ ; а для сдвиговых компонент выполняются условия:  $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ ;  $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ ;  $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ . Нормальные напряжения максимальны вдоль оси  $OZ$  (рис. 5а), а сдвиговые напряжения в этой области минимальны (рис. 5б, в, г). Нормальные напряжения в области локального термического воздействия имеют один знак, а сдвиговые – знакопеременны.

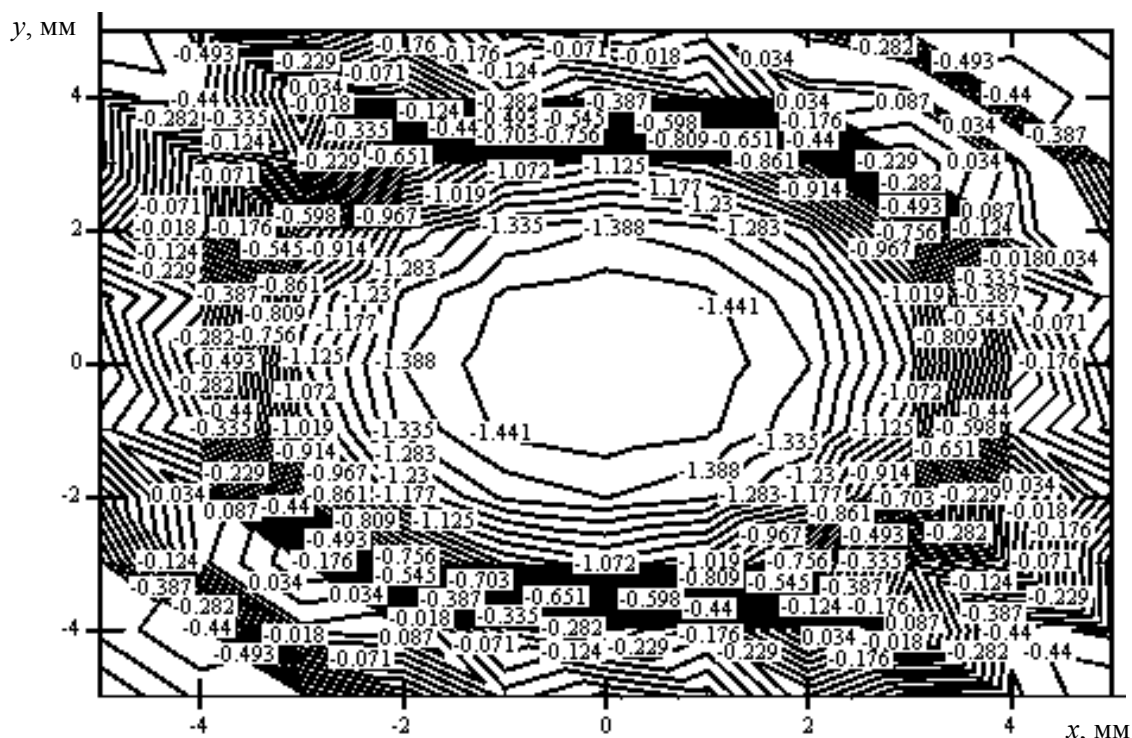


Рис. 5а

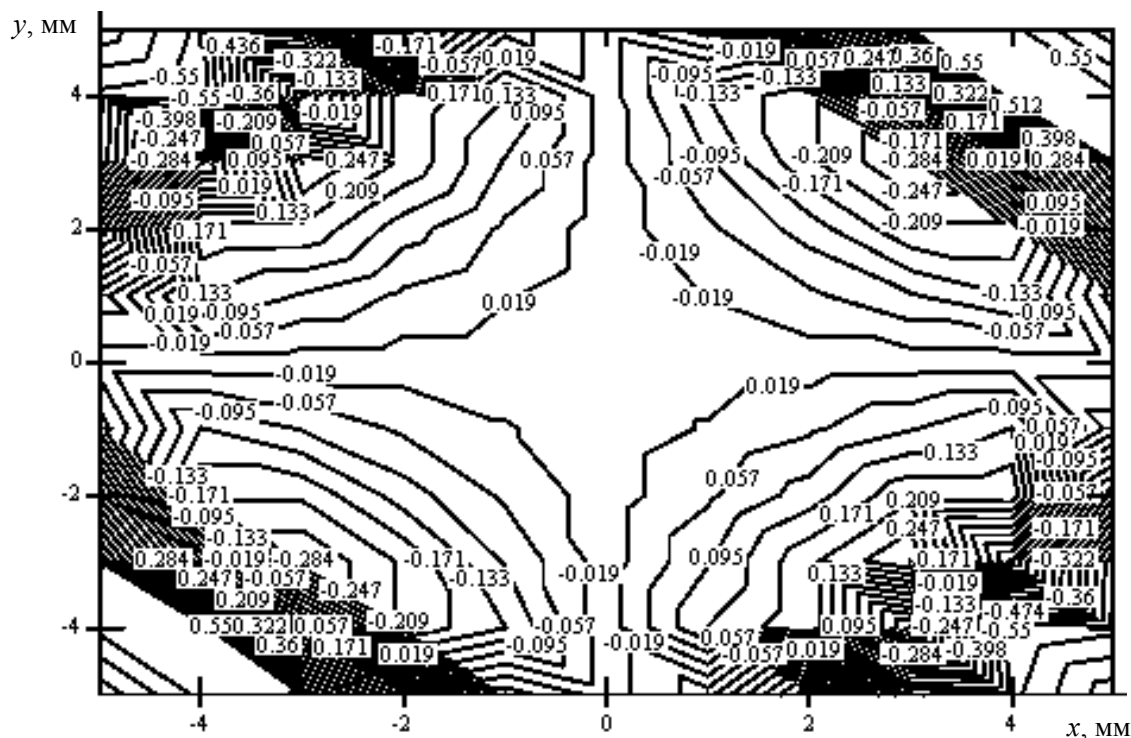


Рис. 5б

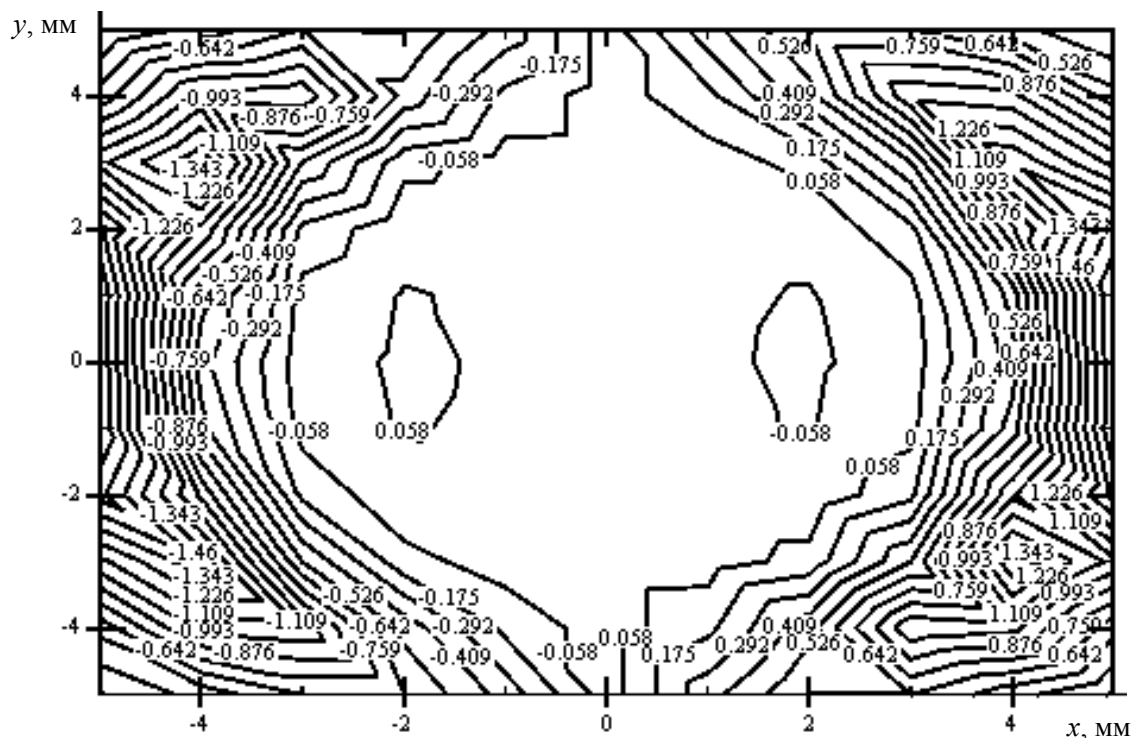


Рис. 5в

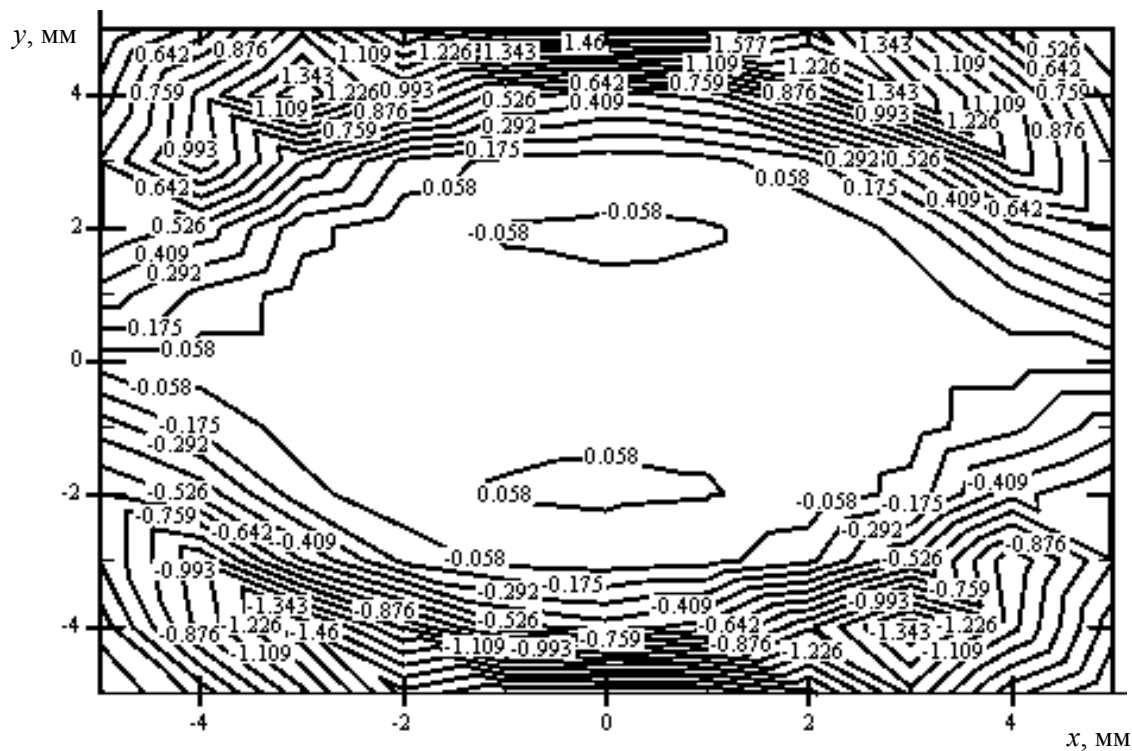


Рис. 5г

Нормальные напряжения способствуют процессам переползания дислокаций и диффузии вакансий и легирующего компонента [6]. Поэтому в центре пятна лазерного воздействия должна наблюдаться максимальная концентрация примесей. Сдвиговые напряжения активизируют процессы зарождения и развития дислокаций [6]. Так как



величина этих напряжений велика и вдали от области локального термического воздействия (см. рис. 5б, в, г), то дислокационные сдвиги могут проходить и в соседних областях по отношению к очагу термического воздействия. Это, в частности, показано на рис. 1а.

В проведенных расчетах диэлектрическая постоянная  $\epsilon_0$  и диэлектрический коэффициент среды  $\epsilon$  учитывались, исходя из следующего соотношения, являющегося критерием подобия

$$kq = \frac{m_1}{m} k_1 b, \quad (23)$$

где  $q$  – заряд;  $b$  – вектор Бюргерса;  $m$  и  $m_1$  – масштабные факторы;  $k = 1/(4\pi\epsilon\epsilon_0)$ ;  $k_1 = \mu/[2\pi(1 - \nu)]$ .

Таким образом, с использованием принципа электростатических аналогий рассчитаны поля напряжений в области локального термического воздействия с учетом влияния на конфигурацию этих напряжений поверхности. Показано, что нормальные напряжения максимальны в центральной части области термического воздействия, а сдвиговые – в соседних областях.

### Литература

1. Попилов Л. Я. Справочник по электрическим и ультразвуковым методам обработки материалов / Л. Я. Попилов. – Л. : Машиностроение, 1977. – 544 с.
2. Владимиров В. И. Физическая природа разрушения металлов / В. И. Владимиров. – М., 1984.
3. Иродов И. Е. Основы электромагнетизма / И. Е. Иродов. – М. : Высш. шк., 1983. – 280 с.
4. Терлецкий Я. П. Электродинамика / Я. П. Терлецкий, Ю. П. Рыбаков. – М. : Высш. шк., 1990. – 352 с.
5. Рябушко А. П. Индивидуальные задания по высшей математике: Ряды. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля / А. П. Рябушко [и др.]. – Мн. : Выш. шк., 2004. – 368 с.
6. Хирт Дж. Теория дислокаций / Дж. Хирт, И. Лоте. – М. : Атомиздат, 1972. – 600 с.
7. Александров А. В. Основы теории упругости и пластичности / А. В. Александров, В. Д. Потапов. – М. : Высш. шк., 1990. – 400 с.

*Получено 21.06.2005 г.*